



## 新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

### 中佛罗里达大学Juin J. Liou教授到微电子所进行学术交流

2011-11-24 | 编辑: 三室 张康玮 | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

11月21日, 中佛罗里达大学Juin J. Liou教授来微电子所进行学术交流, 作了题为 Electrostatic Discharge (ESD) Protection of Modern and Future Integrated Circuits的精彩报告, 并就集成电路中的静电保护与师生等进行了深入的交流和讨论。

报告中, Juin J. Liou教授首先介绍了“静电”是什么和如何产生的, 通过自然界的闪电和日常生活中的静电现象, 深入浅出地引出了集成电路中的静电现象、其对电路中核心芯片的严重危害和电路静电保护的重要性。随后, 他介绍了三种静电模型: 人体模型、器件充放电模型和机械模型。Juin J. Liou教授认为有两种消除静电的措施, 包括环境控制和使用二极管等器件保护, 其中使用器件保护晶片是最常用、最经济的静电保护方法。在介绍芯片静电测试的程序设备和其科研小组在静电保护方面的研究案例时, 通过如汽车电子芯片的静电保护和晶片与核心芯片分开的静电保护等案例, 使在做师生更具体、深刻、直观地了解了芯片静电保护的各种方法。报告的最后, 老师、同学们就静电保护研究中遇到的一些问题与Juin J. Liou教授展开了激烈的讨论。

Juin J. Liou教授在1982年, 1983年和1987年分别获得了佛罗里达大学的电气工程专业的荣誉学士学位、硕士学位和博士学位。1987年, 他加入了中佛罗里达大学(UCF)的电气工程和计算机系。现在他是中佛罗里达大学飞马特聘教授和的模拟器件研究员。他目前的研究兴趣是微/纳米电子计算机辅助设计, 射频器件模型与仿真和静电保护的电路设计和仿真。拥有7项美国专利, 发表过9本书籍和240多篇期刊论文(包括16个邀请文章), 以及在国际和国家会议论文集中发表了190多篇论文(包括78个主题演讲或邀请论文)。此外, Juin J. Liou教授还担任了很多社会职位(比如中国长江学者和IEEE电子器件协会的理事会成员等)和获得了很多奖项及荣誉(例如: 在教学和科研上的卓越表现而获得来自中佛罗里达大学的十个不同奖项和从IEEE获得的6个不同奖项等)。



附件下载:



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编: 100029

单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号, 电子邮件: webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号